

# 大阪工業大学大学院

<工学研究科博士前期課程>

2026年度第1回一般入試問題

電気電子・機械工学専攻

電気電子工学コース

2026年度 大阪工業大学大学院工学研究科 電気電子・機械工学専攻  
電気電子工学コース 第1回一般入学試験問題 電磁気学  
2025/7/5(土)

【注意】問題1. と問題2. は各々、別の解答用紙に解答すること。

問題1. 図1-1のように中心をOとする半径 $a$  [m]の導体球殻Aと半径 $b$  [m]の導体球殻Bがある。導体球殻の厚みは無視できるほど薄い。導体球殻Bは接地されており、導体球殻以外の空間はすべて真空とし、真空の誘電率は $\epsilon_0$  [F/m]とする。

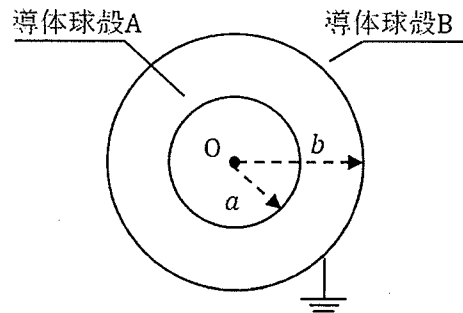


図1-1

- (1) 導体球殻 Aに $+Q$  [C]の電荷を与えたとき、導体球殻Bの内側に誘導される電荷量 $Q_B$  [C]を答えよ。
- (2) 中心Oからの距離 $r$  [m]の位置における電界の大きさ $E$  [V/m]を求めよ。
- (3) 中心Oから距離 $r$  [m]の位置における電位 $V$  [V]を求めよ。
- (4) 中心Oから距離 $r$  [m]の位置における静電場のエネルギー密度 $u_e$  [J/m<sup>3</sup>]を求めよ。
- (5) 系全体の静電エネルギー $U$  [J]を求めよ。

【注意】問題1. と問題2. は各々、別の解答用紙に解答すること。

問題2. 図2-1のように、長さ $2a$ [m]、磁極の強さ $\pm m$  [Wb]の磁石の中心が原点 $O(0,0)$ に置かれている。2つの磁極は $+m$  [Wb]が $(a,0)$  [m]、 $-m$  [Wb]が $(-a,0)$  [m]にあるとする。このとき、磁石の中心から $y$ 軸上の点 $P(0,a)$  [m]における磁界 $H$  [A/m]を、以下の(1)～(3)の手順に従って答えよ。ここで、真空の透磁率を $\mu_0$  [H/m]、 $(x,y)$ 方向の単位ベクトルを $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ とする。答えには単位を必ず示すこと。

- (1) 磁極 $+m$  [Wb]の位置から点 $P$ への位置ベクトル $\mathbf{r}_p$ 、および磁極 $-m$  [Wb]の位置から点 $P(0,a)$  [m]への位置ベクトル $\mathbf{r}_m$ を単位ベクトル $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ を用いて表せ。また、ベクトル $\mathbf{r}_p, \mathbf{r}_m$ の大きさを答えよ。
- (2) 磁極 $+m$  [Wb]および $-m$  [Wb]がそれぞれ点 $P$ につくる磁界 $\mathbf{H}_p$  [A/m]および $\mathbf{H}_m$  [A/m]を単位ベクトル $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ を用いて表せ。
- (3) 点 $P$ における磁界 $\mathbf{H}$  [A/m]を単位ベクトル $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ を用いて表せ。また、磁界 $\mathbf{H}$  [A/m]の大きさを答えよ。

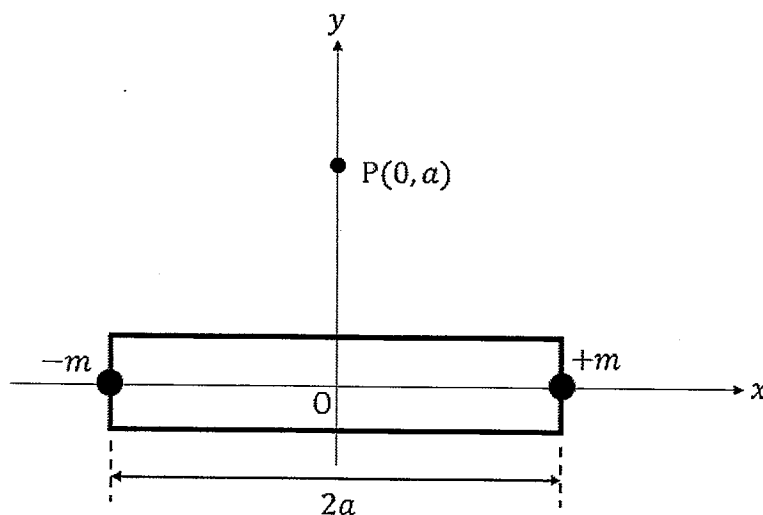
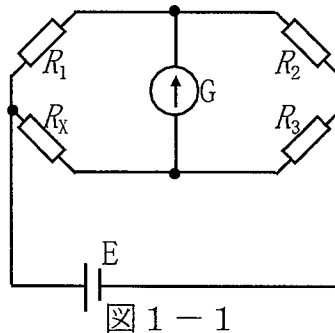


図2-1

【注意】問題1. と問題2. は各々、別の解答用紙に解答すること。

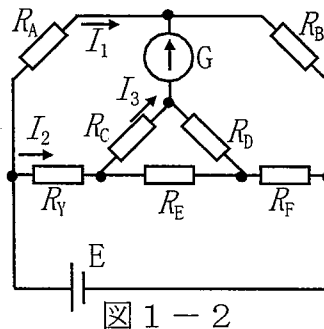
問題1. 次の各問いに答えよ。

- (1) 抵抗  $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_x$ 、検流計  $G$  および直流電源  $E$  からなる図1-1のブリッジ回路が平衡している。回路の平衡条件から  $R_x$  を求めよ。



- (2) 抵抗  $R_A$ 、 $R_B$ 、 $R_C$ 、 $R_D$ 、 $R_E$ 、 $R_F$ 、 $R_Y$ 、検流計  $G$  および直流電源  $E$  からなる図1-2のブリッジ回路が平衡している。 $R_A$ 、 $R_Y$ 、 $R_C$  を流れる電流をそれぞれ  $I_1$ 、 $I_2$ 、 $I_3$  とおく。

- (a) 平衡条件から回路の左側について  $R_A I_1$  を  $I_2$ 、 $I_3$ 、 $R_Y$ 、 $R_C$  を用いて表せ。  
 (b) 同様に回路の右側について  $R_B I_1$  を  $I_2$ 、 $I_3$ 、 $R_F$ 、 $R_D$  を用いて表せ。  
 (c) 分流の公式を利用し、 $I_3$  を  $I_2$ 、 $R_C$ 、 $R_D$ 、 $R_E$  を用いて表せ。  
 (d) (a) ~ (c) の式から  $R_Y$  を求めよ。  
 (e) 回路が平衡しており、かつ  $\frac{R_A}{R_C} = \frac{R_B}{R_D}$  のときの  $R_Y$  を求めよ。



【注意】問題 1. と問題 2. は各々、別の解答用紙に解答すること。

問題 2. 周波数 60 Hz 時に  $R = \omega L = \omega C = 1$  となる抵抗  $R$ 、インダクタ(コイル) $L$ 、キャパシタ(コンデンサ) $C$  を用いて以下の回路を作成した。それぞれの問いに答えよ。なお電源の周波数は 60 Hz、電圧の単位は V、電流の単位は A、電圧は実効値表示であり、解答は複素数、指数表示、あるいは極座標形式で答えてよい。

(1) 図 2-1 の電源電圧を  $\dot{V}_1 = 10e^{j0} (= 10 \angle 0)$  とする。電流  $i_{1R}$ 、 $i_{1L}$ 、 $i_{1C}$  を求めよ。

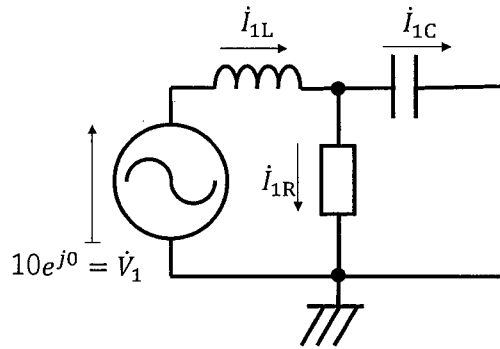


図 2-1

(2) 図 2-2 の電源電圧を  $\dot{V}_2 = 10e^{j\frac{\pi}{3}} (= 10 \angle \frac{\pi}{3})$  とする。電流  $i_{2R}$ 、 $i_{2L}$ 、 $i_{2C}$  を求めよ。

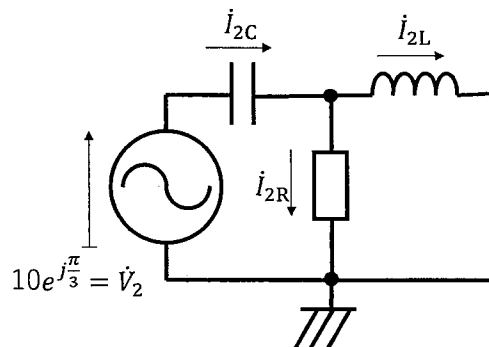


図 2-2

(3) 図 2-3 の電流  $i_R$  を求め、抵抗  $R$  で消費する電力  $P$  [W] を求めよ。

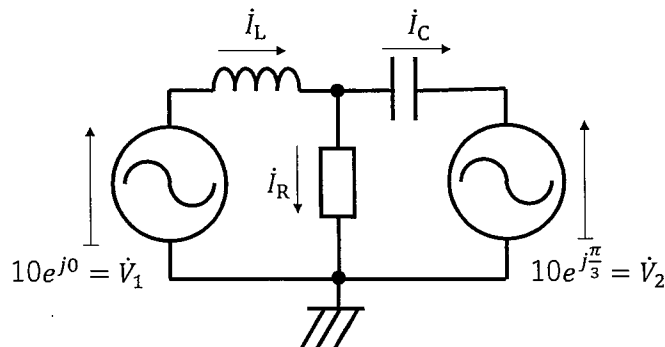


図 2-3

【注意】問題 1. と問題 2. は各々、別の解答用紙に解答すること。

問題 1. 以下の空欄を埋めよ。ただし、空欄②、⑦～⑨については各空欄で指示した記号を用いて数式で答えよ。空欄③～⑤については数値で答えよ。空欄⑥については回路図で解答し、図中に  $v_i$ 、 $v_o$ 、 $i_b$ 、 $i_c$  を示すこと。

図 1 - 1 中のトランジスタ記号は ① 形のバイポーラトランジスタを表している。まず、 $v_i = 0 \text{ V}$  とし、二つの直流電源のみで考え、電源電圧をそれぞれ  $V_{BB}$  と  $V_{CC}$  とする。トランジスタのベース-エミッタ間電圧  $V_{BE}$  とベース電流  $I_B$  の関係式が  $I_B = I_s \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)$  とすると、入力インピーダンス  $h_{ie} = \frac{dV_{BE}}{dI_B}$  は ②  $I_B$ 、 $V_T$  で表される。ここで、 $I_s$  と  $V_T$  は定数であり、 $V_T = 26 \text{ mV}$  とすると、 $I_B = 10 \mu\text{A}$  のときに  $h_{ie}$  は ③  $\Omega$  となる。トランジスタの電流増幅率  $h_{fe}$  が 200 であれば、コレクタ電流  $I_C$  は ④  $\text{mA}$  となる。 $R_L = 2.2 \text{ k}\Omega$  の抵抗を接続し、 $V_{CC} = 9.0 \text{ V}$  とすると、コレクタ-エミッタ間電圧  $V_{CE}$  は ⑤  $\text{V}$  となる。

次に、電圧  $v_i (\neq 0 \text{ V})$  の小信号を入力し、ベース電流  $i_b$  とコレクタ電流  $i_c$  が流れる場合を考える。出力アドミタンスと電圧帰還率を省略して図 1 - 1 を小信号等価回路で表すと、⑥ のようになる。コレク

ターエミッタ間電圧  $v_{ce}$  が出力  $v_o$  であり、

電圧増幅度  $A_v$  は ⑦  $h_{ie}$ 、 $h_{fe}$ 、 $R_L$ 、

電力増幅度  $A_p$  は ⑧  $h_{fe}$ 、 $A_v$  とな

る。電圧利得  $G_v$  は ⑨  $A_v$  であり、単

位は ⑩ である。

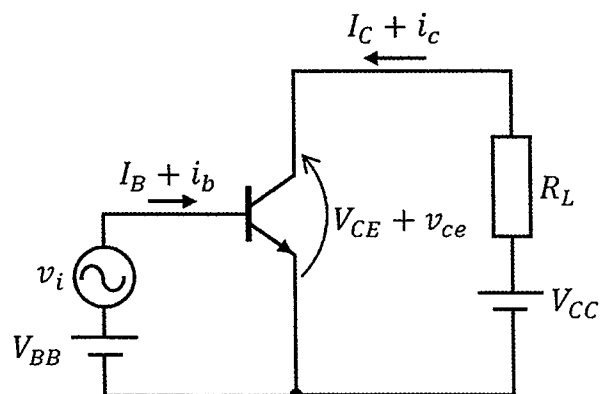


図 1 - 1

【注意】問題 1. と問題 2. は各々、別の解答用紙に解答すること。

問題 2. 以下の問に答えよ。

- (1) 図 2-1 に示す組み合わせ回路における出力 Z が表 2-1 のようになるためには、A に AND、OR、NAND、NOR のいずれのゲートを挿入すればよいか、理由とともに示せ。

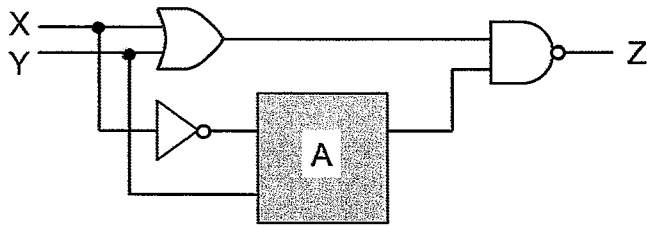


図 2-1

表 2-1

X	Y	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- (2) 次の論理式を簡単化せよ。

$$Z = ABC\bar{D} + AB\bar{C}D + A\bar{B}CD + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}A\bar{B}C$$

- (3) 図 2-2 の論理回路において、入力 A、B がそれぞれ 1 および 0、出力 X、Y がそれぞれ 1 および 0 であるとする。この状態から A を 0 に変更した後、B を 1 にした。この操作後の X、Y の値を根拠とともに示せ。

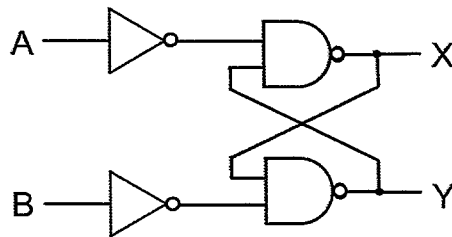


図 2-2

2026年度 大阪工業大学大学院工学研究科 電気電子・機械工学専攻  
電気電子工学コース 第1回一般入学試験問題 電気数学  
2025/7/5(土)

【注意】問題1. と問題2. は各々、別の解答用紙に解答すること。

問題1.  $A, B, C, D, I, O$ をそれぞれ、 $n$ 行 $n$ 列の行列とし、 $I$ は単位行列、 $O$ は零行列とする。

また、 $A^{-1}, B^{-1}$ は $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ ,  $B^{-1}B = BB^{-1} = I$ を満たす $n$ 行 $n$ 列の行列とする。

(1)  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$  を証明せよ。

(2) 積  $\begin{bmatrix} I & O \\ DA^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & O \\ O & B - DA^{-1}C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A^{-1}C \\ O & I \end{bmatrix}$  を計算せよ。

(3)  $\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$  を証明せよ。

(4)  $\begin{bmatrix} I & A^{-1}C \\ O & I \end{bmatrix}^{-1}$ ,  $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B - DA^{-1}C \end{bmatrix}^{-1}$ ,  $\begin{bmatrix} I & O \\ DA^{-1} & I \end{bmatrix}^{-1}$  をそれぞれ計算せよ。

(5)  $\begin{bmatrix} A & C \\ D & B \end{bmatrix}^{-1}$  を $A, B, C, D$ および $A^{-1}, B^{-1}, (B - DA^{-1}C)^{-1}$  を用いて表せ。

【注意】問題1. と問題2. は各々、別の解答用紙に解答すること。

問題2. ベクトル場  $\mathbf{E}(x, y, z) = E_x \mathbf{i} + E_y \mathbf{j} + E_z \mathbf{k} = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} = \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$  につ

いて以下の問いに答えよ。計算の導出過程も書くこと。ただし、 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  は基底

ベクトルを表し、 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix}$  とする。

(1)  $\frac{\partial E_x}{\partial y}$  を計算し求めよ。

(2)  $\nabla \times \mathbf{E}(x, y, z)$  を計算し求めよ。

(3) 図2-1の閉経路  $C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$  上の任意の点の位置ベクトルを  $\mathbf{r}$  とする。このとき、つぎの線積分を計算せよ。

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

なお、ストークスの定理

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot n dS$$

を用いてもよい。ここで、 $S$  は  $C$  で囲まれた領域を表し、 $n dS$  はベクトル面積素を表す。

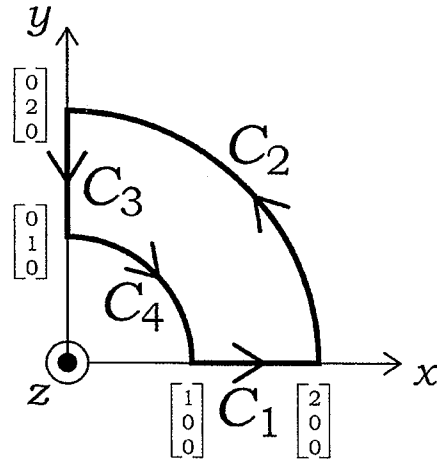


図2-1 閉経路  $C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$

(4) 経路  $C_1$  を、 $[1 \ 0 \ 0]^T$  から  $[2 \ 0 \ 0]^T$  までの  $C$  上に沿った経路とする。このとき、つぎの線積分を計算せよ。ここで、 $T$  は転置を表す。

$$\int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$